

УДК 536.424

**ИНДУЦИРОВАННЫЙ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ПЕРЕХОД
ИЗ СЛАБО- В СИЛЬНОАНИЗОТРОПНОЕ СОСТОЯНИЕ
В ТЕРБИЙ-ИТТРИЕВЫХ ФЕРРИТАХ-ГРАНАТАХ**

A. С. Лагутин, A. В. Дмитриев

Проведено исследование намагниченности и дифференциальной магнитной восприимчивости монокристаллов $Tb_xY_{3-x}Fe_5O_{12}$ ($x < 0.5$) в импульсных магнитных полях амплитудой до 40 Тл при $T = 4.2$ К. Обнаружено, что процесс перемагничивания редкоземельной подсистемы таких ферритов-гранатов происходит одним или несколькими скачками магнитного момента в зависимости от ориентации поля относительно кристаллографических осей образцов. Полученные результаты интерпретируются в предположении возникновения в поле некомпланарной структуры, образованной изинговскими магнитными моментами. Экстраполяцией к $x \rightarrow 0$ определена величина эффективного поля обменного взаимодействия между редкоземельной и «железной» подсистемами феррита-граната тербия.

Для построения теории, позволяющей установить однозначное соответствие между микроскопическими характеристиками магнитных ионов кристалла и его термодинамическими свойствами, необходимо знать величины обменных и анизотропных взаимодействий в изучаемых соединениях.

Поэтому одной из задач данного исследования было определение величины обменного взаимодействия между редкоземельными (РЗ) ионами и «железной» подсистемой гранатов $Y_{3-x}Tb_xFe_5O_{12}$, а также величин констант магнитной кристаллографической анизотропии в таких соединениях при гелиевых температурах.

В проведенных ранее экспериментах [1, 2] были обнаружены скачки намагниченности монокристаллов $Y_{3-x}Tb_xFe_5O_{12}$ ($x < 0.65$) в полях около 10 Тл при $T = 4.2$ К. Эти аномалии интерпретировались на основе модели инверсии энергетических уровней иона Tb^{3+} в магнитном поле, предложенной Купером [3] для объяснения магнитных свойств TmSb. При достаточно низких температурах инверсия основного состояния сопровождается скачками магнитного момента [4, 5]. Если предположить, что такой процесс происходит до момента перемагничивания РЗ иона, т. е. в полях $H < H_{\text{об}}$, то в полях $H > H_{\text{об}}$ должна иметь место обратная инверсия уровней РЗ иона. При этом поля подобных переходов будут расположены симметрично относительно $H_{\text{об}}$ ($H_{\text{об}}$ — эффективное поле обменного взаимодействия РЗ ионов и ионов железа). Была предпринята попытка обнаружить такое явление в монокристалле $Y_{2.74}Tb_{0.26}Fe_5O_{12}$ [6], однако искомый результат не был получен. Было найдено, однако, что перемагничивание магнитных моментов РЗ ионов в этом соединении происходит не путем двух фазовых переходов второго рода, как в слабоанизотропных ферритах-гранатах, например в $Gd_{0.5}Y_{2.5}Fe_5O_{12}$ [7], а одним или двумя переходами первого рода.

Такой процесс намагничивания характерен для сильноанизотропных (изинговских) магнетиков и рассмотрен в [8]. Там же отмечено, что наиболее близкими по свойствам к такой модели являются гранаты с ионами Ho, Dy, Tb. Эксперименты, проведенные на системе $Ho_xY_{3-x}Fe_5O_{12}$ [9], показали хорошее согласие с теорией, тогда как для $Tb_{0.26}Y_{2.74}Fe_5O_{12}$

не удается получить даже качественного согласия теории и эксперимента. Поэтому второй задачей данного исследования было выяснить, как происходит перемагничивание редкоземельной магнитной подсистемы таких гранатов.

1. Методика экспериментов и образцы

Для решения поставленных задач был выбран индукционный метод измерения намагниченности и дифференциальной магнитной восприимчивости. Магнитное поле амплитудой до 40 Тл длительностью 12 мс создавалось разрядом конденсаторной батареи на многовитковый соленоид [10]. Индукционный датчик представлял собой две коаксиальные (одна поверх другой) катушки, скомпенсированные с точностью до витка; рабочий диаметр датчика 4 мм [7]. Дальнейшая компенсация датчика проводилась с использованием цепей амплитудной и фазовой коррекции [11].

Магнитное поле измерялось расположенной вблизи от образца полевой катушкой, прокалиброванной по сигналу ЭПР в дифенилпикрилгидразиле в поле 7 Тл.

Напряжения с индукционного датчика и полевой катушкой поступали на входы прецизионных электронных интеграторов (ошибка интегрирования около 0.1 %). С выхода интеграторов напряжения, пропорциональные временным зависимостям магнитного момента образца и магнитного поля, подавались на два идентичных канала цифрового регистратора однократных процессов (меморископа) [12]. На третий канал меморископа поступало напряжение с датчика (без интегрирования), пропорциональное временной зависимости дифференциальной магнитной восприимчивости. Числовые массивы из каналов меморископа считывались в ЭВМ «Искра-226», с помощью которой велась дальнейшая обработка информации, включающая в себя вычитание из суммарного сигнала напряжения раскомпенсации, калибровку по эталону, расчет дифференциальной магнитной восприимчивости путем деления измеренного значения dM/dt на производную магнитного поля.

При измерениях намагниченности эталоном служил монокристалл железо-иттриевого феррита-граната, а для измерения восприимчивости в качестве эталона использовался монокристалл MnF_2 ; магнитное поле ориентировалось при калибровке вдоль направления оси C_4 этого кристалла. Погрешность абсолютных измерений не превышала 10 %, причем основной вклад в нее вносило различие формы исследуемых образцов и эталонных.

Все измерения проводились на монокристаллических образцах, выращенных сотрудниками проблемной лаборатории магнетизма МГУ по методу «из раствора в расплаве». Шихта приготавливалась из окислов с чистотой не менее 99.99 %. Состав образцов определялся методом рентгеноспектрального анализа на микроанализаторе УХА-5 (Япония), точность определения x была не хуже 0.02. Для измерений намагниченности и восприимчивости использовались образцы цилиндрической формы длиной 4–5 и диаметром 2–3 мм. Ошибка в ориентации кристаллографических осей образца относительно магнитного поля не превышала 3°.

2. Результаты экспериментов и обсуждение

а) Слабые магнитные поля ($\mu_0 H < 6$ Тл). Экспериментальные зависимости магнитного момента монокристаллов $Tb_x Y_{3-x} Fe_5 O_{12}$ от магнитного поля, полученные при ориентациях поля вдоль основных кристаллографических направлений, приведены на рис. 1, а–в. Для всех составов легким направлением является направление [100]. При $H \parallel [111]$ переход в состояние с максимальным моментом происходит скачкообразно для составов с $x=0.1$ и 0.26, а при $x=0.41$ имеет место плавный переход в такое состояние. Плавное нарастание намагниченности наблюдается и при ориентации поля вдоль оси [110]; исключение состав

ляет состав с $x=0.1$, в котором есть небольшой скачок момента в поле около 0.3 Тл. Если предположить, что магнитные моменты всех шести неэквивалентных позиций РЗ иона [13] параллельны, то магнитный момент изучаемых соединений в расчете на формульную единицу можно представить в виде $M = M_{\text{Fe}} - M_{\text{Tb}} x$, где $M_{\text{Fe}} = 5 \mu_B$, а $M_{\text{Tb}} = 9 \mu_B$. Сравнение расчетных значений магнитных моментов в нулевом поле с экспериментальными данными дает возможность говорить о правдоподобности сделанного предположения.

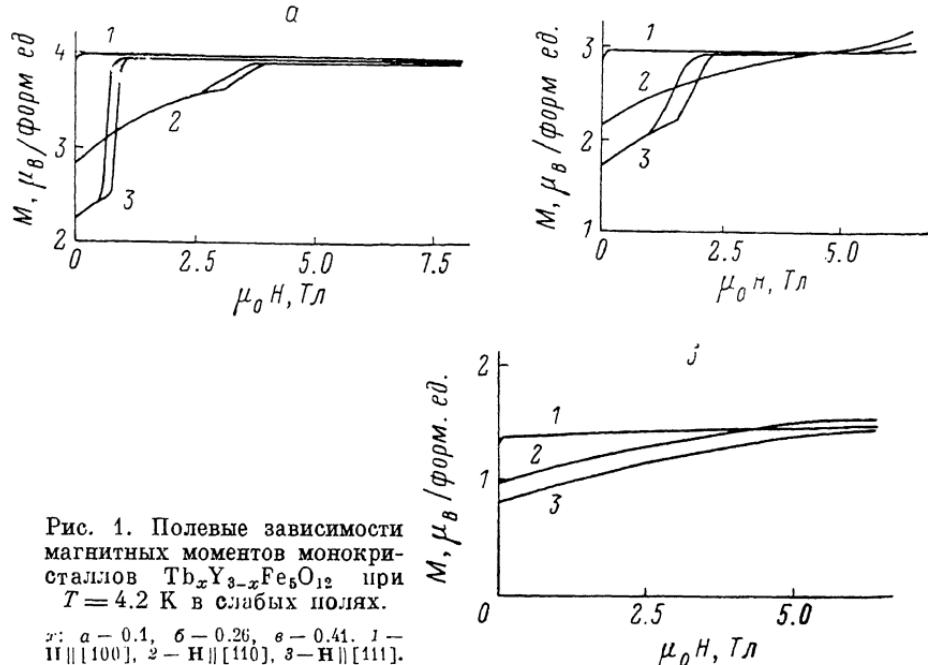


Рис. 1. Полевые зависимости магнитных моментов монокристаллов $\text{Tb}_x\text{Y}_{3-x}\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ при $T = 4.2$ К в слабых полях.

где: а — 0.1, б — 0.26, в — 0.41. 1 — $H \parallel [100]$, 2 — $H \parallel [110]$, 3 — $H \parallel [111]$.

Результаты эксперимента (рис. 1, а—в) были использованы для расчета констант магнитной кристаллографической анизотропии. Значения констант (см. таблицу) определялись в предположении справедливости разложения свободной энергии тербий-иттриевого феррита-граната (ТИФГ) в ряд по степеням магнитного момента и при учете только двух первых членов этого ряда, что достаточно для описания свойств ТИФГ при температурах 100—200 К [14]. Из этой таблицы видно, что при увеличении x происходят значительные изменения обоих констант вплоть до смены знака. Логично связать этот результат с наличием в этих соединениях большого магнитоупругого вклада в константы магнитной анизотропии [15] и предположить, что различие в константах анизотропии для составов с разными x проявится и в более сильных полях.

б) Сильные магнитные поля ($\mu_0 H > 6$ Тл). Полевые зависимости магнитного момента ТИФГ при разных x в сильных полях приведены на рис. 2, а—в. Для всех составов в полях от 6 до 16 Тл имеют место скачки момента, величина которых изменяется линейно с x . Такие поля значительно превосходят поля технического намагничивания, однако магнитные моменты образцов при этом меньше, чем в чистом железо-итриевом феррите-гранате. Это говорит о том, что перемагничивания редкоземельной подсистемы еще не произошло. Известно также, что аномалии магнитного момента в данном интервале полей сопровождаются аномалиями магнитострикции [1] и эффекта Фарадея [2].

Константы анизотропии
 $\text{Tb}_x\text{Y}_{3-x}\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ при $T = 4.2$ К

x	$K_1, 10^5 \text{ Дж/м}^3$	$K_2, 10^5 \text{ Дж/м}^3$
0.1	3.4	-16.7
0.26	2.1	-1.5
0.41	1.1	5.1

В полях, превышающих 20 Тл, также обнаружен скачкообразный процесс намагничивания ТИФГ, причем число скачков момента и их величина

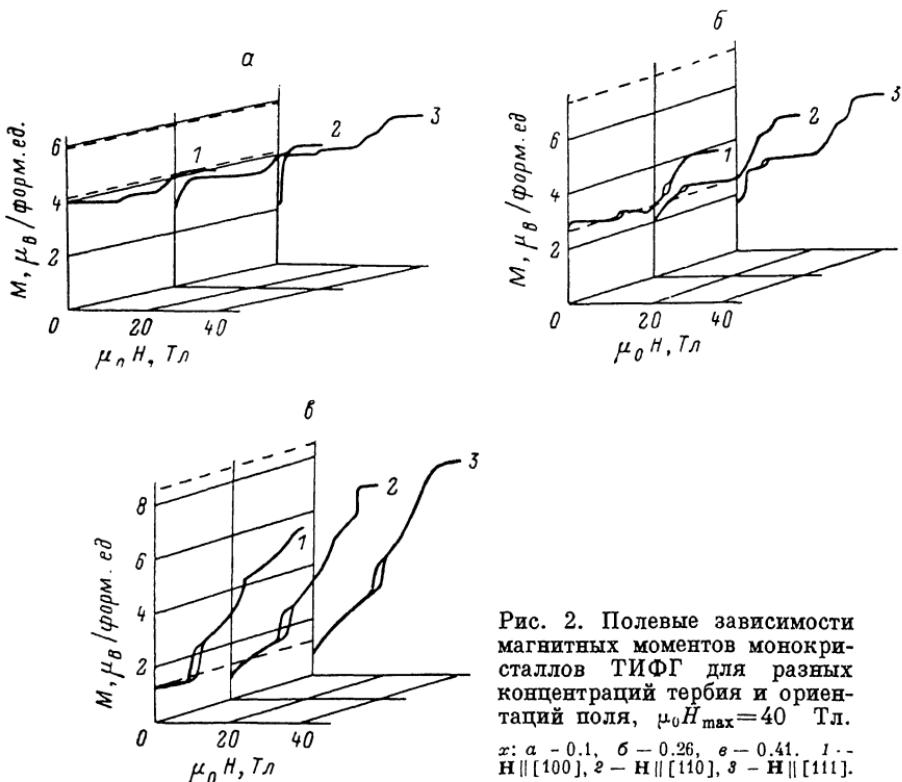


Рис. 2. Полевые зависимости магнитных моментов монокристаллов ТИФГ для разных концентраций тербия и ориентаций поля, $\mu_0 H_{\max} = 40$ Тл.
x: a - 0.1, b - 0.26, c - 0.41. 1 - $H \parallel [100]$, 2 - $H \parallel [110]$, 3 - $H \parallel [111]$.

варьируются в зависимости от состава и ориентации внешнего поля относительно кристаллографических осей. Характерно, что и в самых больших

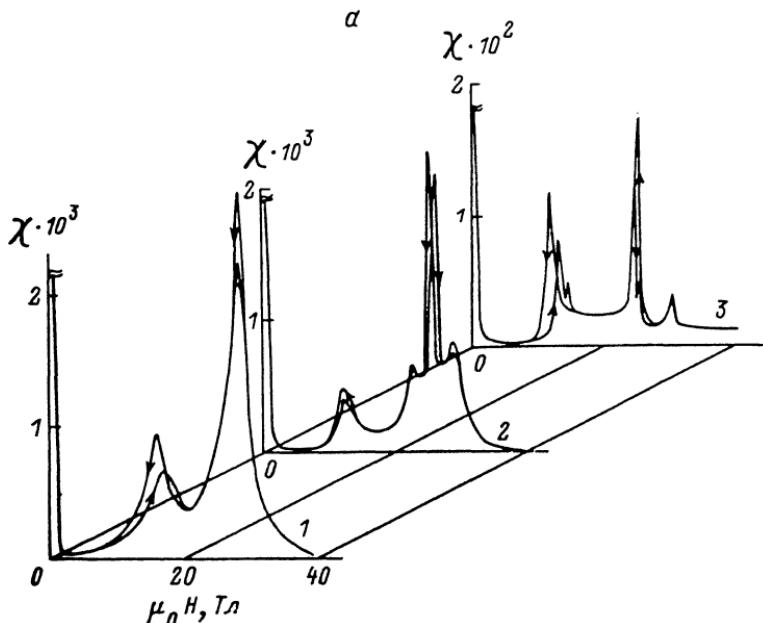


Рис. 3. Зависимости дифференциальной магнитной восприимчивости монокристаллов $Tb_x Y_{3-x} Fe_5 O_{12}$ для разных x , полученные при различных ориентациях внешнего поля относительно осей кристаллов.

a - $H \parallel [100]$, б - $H \parallel [110]$, в - $H \parallel [111]$. x: 1 - 0.1, 2 - 0.26, 3 - 0.41.

полях магнитные моменты образцов далеки от величин, соответствующих ферромагнитному состоянию ферримагнетика (параллельная ориентация M_{Fe} и M_{Tb}).

Похожее поведение намагниченности было обнаружено в гольмий-иттриевых ферритах-гранатах [9], для описания свойств которых использовалась Z-изинговская модель ферримагнетика [15]. В случае же ТИФГ эта модель не работает, во всяком случае без существенных дополнений.

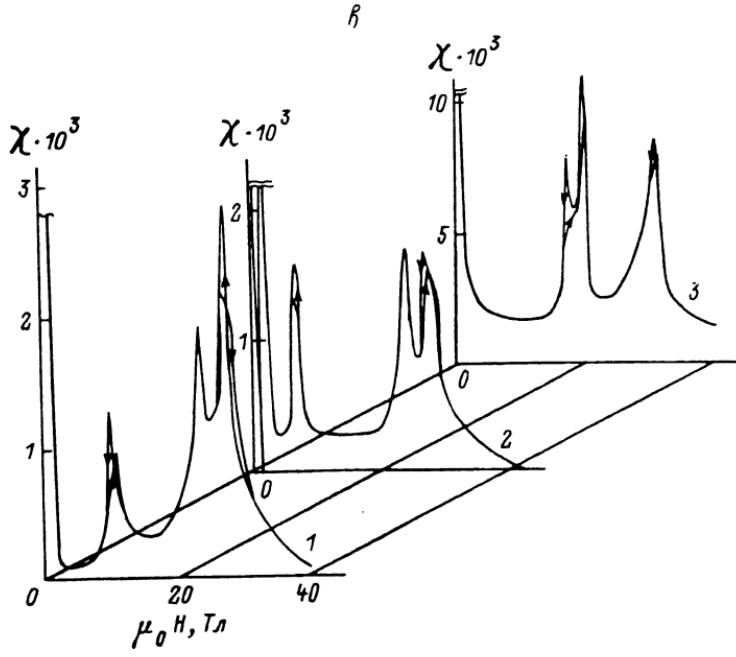
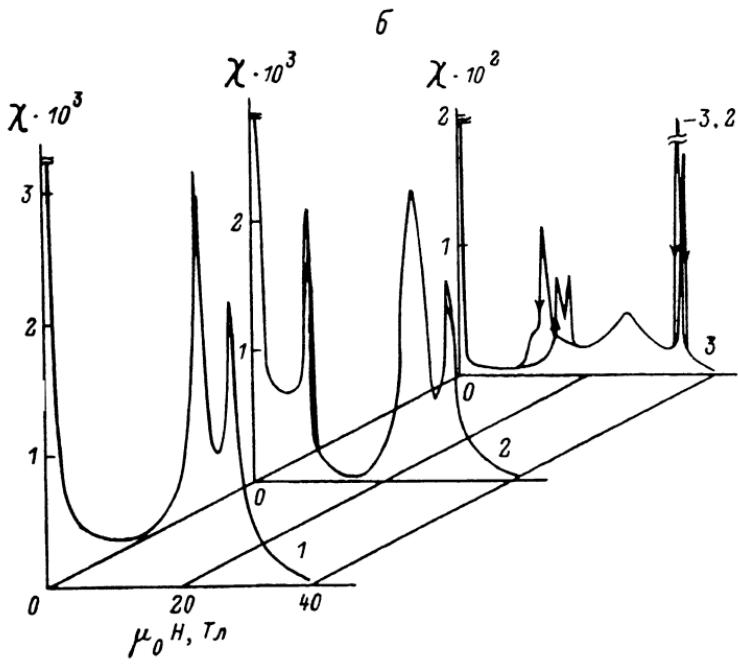


Рис. 3 (продолжение).

Попытка применить альтернативную X—Y-изинговскую модель также не привела к успеху. В обоих случаях не удалось добиться даже качественного соответствия теории и эксперимента.

Ключ к решению задачи был найден при анализе фазовых диаграмм ТИФГ на плоскости «поле—концентрация», для построения которых были использованы экспериментальные полевые зависимости дифференциальной магнитной восприимчивости (рис. 3, а—в). Видно, что величина $\chi = dM/dH$

при фазовых переходах в полях порядка 20 Тл велика и близка к значению, соответствующему переходу первого рода.

Магнитные фазовые диаграммы на плоскости $H-x$ показаны на рис. 4, а-в. Точками 1, 2 на них указаны поля, соответствующие максимумам восприимчивости. Вертикальные отрезки показывают полуширину переходов, измеренную на полувысоте соответствующих пиков восприимчивости.

Линии фазовых переходов сходятся при $x \rightarrow 0$ к одной точке, в которой $\mu_0 H_0 = 28 \pm 2$ Тл. Такое поведение характерно для фазовых диаграмм редкоземельных ферритов-гранатов вне зависимости от рода перехода в полях, где происходит перемагничивание редкоземельной подсистемы [7, 9]. В таком случае $\mu_0 H_0$ есть эффективное поле обменного взаимодействия между редкоземельной и «железной» подсистемами ТИФГ.

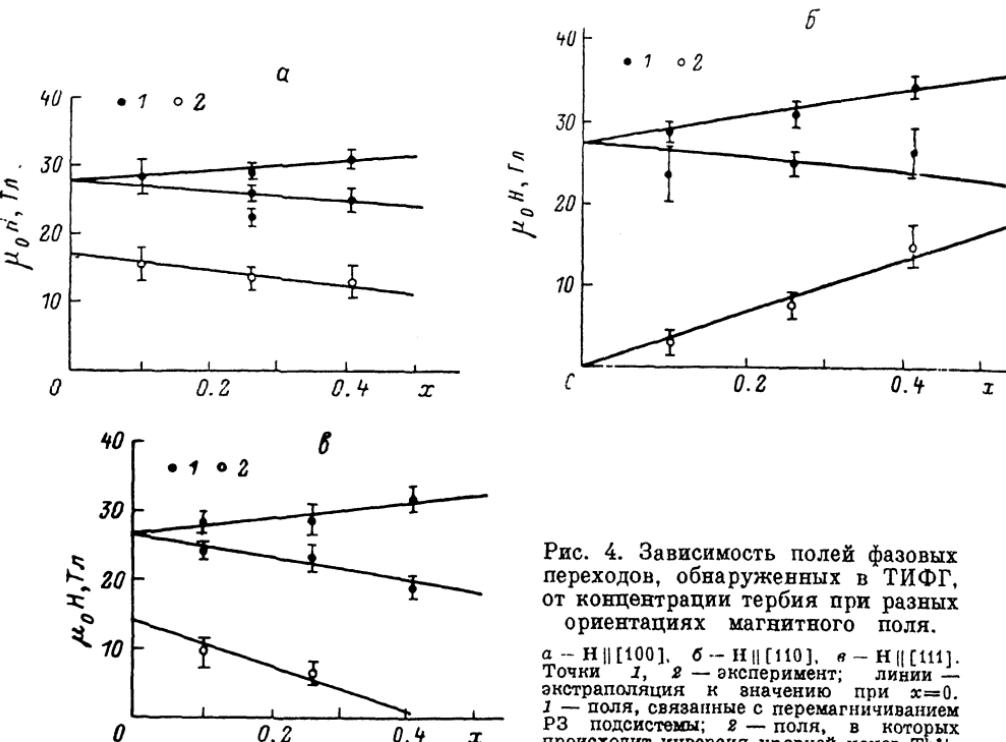


Рис. 4. Зависимость полей фазовых переходов, обнаруженных в ТИФГ, от концентрации тербия при разных ориентациях магнитного поля.

а — $H \parallel [100]$, б — $H \parallel [110]$, в — $H \parallel [111]$. Точки 1, 2 — эксперимент; линии — экстраполяция к значению при $x=0$. 1 — поля, связанные с перемагничиванием РЗ подсистемы; 2 — поля, в которых происходит инверсия уровней ионов Tb^{3+} .

Рассмотрим более подробно фазовую диаграмму при $H \parallel [100]$ в полях, больших 20 Тл. При $x=0.1$ имеет место один переход первого рода, при $x=0.26$ наблюдается один переход первого рода и вблизи от него два других, о рода которых судить затруднительно. В кристалле с $x=0.41$ перемагничивание редкоземельной подсистемы происходит двумя переходами первого рода. Если теперь положить, что с изменением состава меняется и ориентация изинговской оси РЗ иона, то свойства ТИФГ в больших полях уже можно описать в рамках Z-изинговской модели ферримагнетика [15]. Если это так, то экспериментальные результаты говорят о том, что с ростом x направление [100] последовательно становится трудным, легким и, наконец, промежуточным, а при $x=0.41$ ни одно из главных направлений кубического кристалла не является легкой осью. Физической причиной такого магнитного поведения ТИФГ может быть деформация кислородного окружения, обусловленная сильным магнитоупругим взаимодействием. Из-за этой деформации и происходит перестройка уровней РЗ иона, приводящая к изменению основного состояния, в том числе и к смене ориентации изинговской оси. Подтверждением существенного влияния магнитоупругого взаимодействия на магнитные свойства ТИФГ служат изложенные выше результаты по определению констант анизотропии.

Итак, в полях менее 10 Тл свойства исследованных образцов близки к свойствам слабоанизотропных гранатов, тогда как в больших полях они

напоминают свойства сильноанизотропных изинговских магнетиков. Следовательно, в промежуточных полях должен иметь место переход от одного типа поведения к другому. Такой переход может проявляться на магнитных характеристиках ТИФГ, и обнаруженные нами аномалии намагниченности и восприимчивости в полях $6 < \mu_0 H < 16$ Тл мы связываем именно с подобным переходом, обусловленным пересечением уровней РЗ иона в магнитном поле. В отличие от [2] мы полагаем, что при этом происходит не зануление магнитного момента на одном из неэквивалентных для РЗ иона мест, а возникает неколлинеарная и некомпланарная редкоземельная магнитная структура, подобная наблюдавшейся в гольмий-иттриевых ферритах-гранатах [9]. Новое основное состояние РЗ ионов и обусловливает изинговские свойства ТИФГ и задает ориентацию самой изинговской оси — для каждого из неэквивалентных мест РЗ ионов [13]. В первом приближении (без учета взаимодействия РЗ ионов между собой) поля, в которых имеет место пересечение уровней (H_x), не должны зависеть от концентрации этих ионов [16]. Полученную в эксперименте зависимость H_x от x можно также объяснить наличием сильного магнитоупругого взаимодействия в РЗ подсистеме, которое оказывается на изменении энергетического спектра ионов, вызванном деформацией кристаллической решетки, которая в свою очередь пропорциональна x .

Модель возникновения в промежуточных полях некомпланарной магнитной структуры в ТИФГ может также объяснить и отсутствие аномалий намагниченности и восприимчивости для составов с $x=0.1$ и 0.41 при $H \parallel [111]$. Действительно, возможна ситуация, в которой, несмотря на изменение основного состояния и, следовательно, магнитного момента РЗ иона, аномалий намагниченности не будет, если скачок момента на узле сопровождается возникновением некомпланарной магнитной структуры, что связано с уменьшением суммарного РЗ момента. В результате измеряемое изменение магнитного момента граната может быть очень малым и даже нулевым.

Авторы признателны В. И. Ожогину за постоянный интерес к работе. Они очень благодарны Р. З. Левитину за предоставление образцов и многократные обсуждения экспериментальных результатов. Авторы благодарят также А. К. Звездина, А. И. Попова и В. В. Дружинина за полезные дискуссии.

Л и т е р а т у р а

- [1] Демидов В. Г., Левитин Р. З., Попов Ю. Ф. ФТТ, 1976, т. 18, № 2, с. 596—598.
- [2] Валиев У. В., Кринчик Г. С., Левитин Р. З., Мухимов К. М. Письма в ЖЭТФ, 1979, т. 29, № 4, с. 239—243.
- [3] Cooper B. R. Phys. Lett., 1966, vol. 22, N 3, p. 244—245.
- [4] Varret F. J. Phys. Chem. Sol., 1976, vol. 37, p. 257—262.
- [5] Amaya K., Yamashita N. J. Phys. Soc. Jap., 1977, vol. 42, N 1, p. 24—30.
- [6] Лагутин А. С., Гуртовой К. Г. Тез. докл. II Междунар. конф. по физике магнитных явлений. Ядвидшин (ПНР), 1984, с. 212.
- [7] Гуртовой К. Г., Лагутин А. С., Ожогин В. И. ЖЭТФ, 1980, т. 78, № 2, с. 847—853.
- [8] Звездин А. К., Мухин А. Л., Попов А. И. ЖЭТФ, 1977, т. 72, № 3, с. 1097—1110.
- [9] Силантьев В. И., Попов А. И., Левитин Р. З., Звездин А. К. ЖЭТФ, 1980, т. 78, № 2, с. 640—655.
- [10] Лагутин А. С., Ожогин В. И. ПТЭ, 1981, № 3, с. 195—198.
- [11] Allain Y., Gunzbourg J., Krebs J. P., Miedan-Gros A. Rev. Sci. Inst., 1968, vol. 39, p. 1360—1366.
- [12] Стародумов В. Я. ПТЭ, 1984, № 2, с. 61—65.
- [13] Белов К. П. Редкоземельные магнетики и их применение. М.: Наука, 1980. 240 с.
- [14] Белов К. П., Звездин А. К., Левитин Р. З. и др. ЖЭТФ, 1975, т. 68, № 3, с. 1189—1202.
- [15] Белов К. П., Звездин А. К., Кадомцева А. М., Левитин Р. З. Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. М.: Наука, 1979. 317 с.
- [16] Звездин А. К., Матвеев В. М., Мухин А. Л., Попов А. И. Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. М.: Наука, 1985. 234 с.